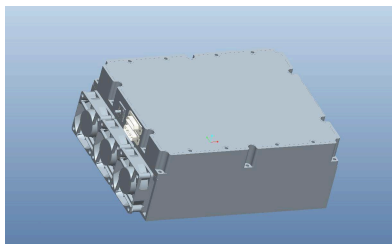


مضخم قدرة GaN RF 8000–12000 MHz، نموذجي 100 W



يغطي مضخم GaN نطاق 8000–12000 MHz بخرج مشيع نموذجي 100 W وكسب أدنى 53 dB. الخرج النموذجي عند انضغاط 1 dB هو 20 W، واستواء الكسب النموذجي ± 1.5 dB.

المواصفات الكهربائية · +28.0VDC; 25°C; 50Ω

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
تردد التشغيل	BW	8000	-	12000	MHz
قدرة الخرج عند انضغاط 1 dB	P-1dB	-	20	-	W
قدرة خرج RF @ PSAT	PSAT	-	100	-	W
كسب القدرة @ PSAT	Gp	53	-	-	dB
استواء كسب القدرة @ PSAT	ΔGp	-	± 1.5	-	dB
فقد العودة عند الدخل	S11	-	-15	-	dB
الإشارات الطفيلية @ PSAT	Spur	-	-60	-	dBc
ممانعة الدخل/الخرج	Impedance	-	50	-	Ω
جهد التشغيل	VDC	-	28	-	VDC

القيم القصوى المطلقة

المعامل	القيمة المقننة
قدرة دخل RF دون تلف	+10 dBm الحد الأقصى
VSWR الحمل عند Pout = 100 W	∞; جميع أطوار الحمل وسعته؛ مستمر
الحمل الحراري الزائد	85 °C → إيقاف التشغيل (الحد الأقصى)

المواصفات البيئية · أهداف تصميم؛ يلزم تأكيدها للمشروع

المعامل	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة	ملاحظات
درجة حرارة التشغيل	-20	-	50	°C	-
درجة حرارة التخزين	-25	-	65	°C	درجة حرارة التخزين
الرطوبة النسبية (دون تكاثف)	-	-	95	%	-

المواصفات الميكانيكية

المعامل	القيمة	الوحدة
الأبعاد	250 × 200 × 100 mm (الحد الأقصى)	mm
الوزن	5.7 kg (الحد الأقصى)	kg
موصل دخل RF	SMA, أنثى	-
موصل خرج RF	N-K	-
واجهة DC والتحكم	هجين, D-Sub 7W2, ذكر	-

واجهة DC والتحكم

رقم الطرف	الوصف	الموصوفة
A1	— A1 الأرضي	الأرضي
A2	— A2 تغذية موجبة	+28V
1	— 1 التمكين	مستوى TTL مرتفع (3.3 V)؛ سحب داخلي إلى المستوى المنخفض
2	— 2 الأرضي	الأرضي
3	— 3 خرج قياس الحرارة	750 ±20 mV @25 °C; 10 mV/°C
4	— 4 خرج قياس التيار	100 mV/A
5	— 5 الأرضي	الأرضي

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المؤد.